

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
|  UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI | FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI | Cod: FD/M 8.1 |
| | | Ediția 1 |
| | | Revizia 0 |
| | | Pagina |

ANEXA 3

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI

MD-2045, CHIȘINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 022 32-39-73 | FAX: 022 32-39-71, www.utm.md
DISPOZITIVE MICRONANOELECTRONICE
1. Date despre disciplină/modul

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Facultatea | Calculatoare, Informatică și Microelectronică | | | | |
| Departamentul | Microelectronică și Inginerie Biomedicală | | | | |
| Ciclul de studii | Studii superioare de licență, ciclul I | | | | |
| Programul de studii | 525.4 –Microelectronica și Nanotehnologii | | | | |
| Anul de studii | Semestrul | Tip de evaluare | Categorie formativă | Categorie de optionalitate | Credite ECTS |
| | 4 | E | S – unitate de curs de specialitate | O - unitate de curs obligatorie | 6 |

2. Timpul total estimat

| Total ore în planul de învățământ | Din care | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Ore auditoriale | | Lucrul individual | | |
| | Curs | Laborator/seminar | Proiect de an | Studiul materialului teoretic | Pregătire aplicații |
| 150 | 45 | 30/15 | - | 45 | 15 |

3. Precondiții de acces la disciplină/modul

| | |
|--------------------------------|---|
| Conform planului de învățământ | Cunoștințe din Fizică, Matematică, Fizica Semiconducторilor, Circuite și Dispozitive Electronice, Electrotehnică, Informatică. |
| Conform competențelor | Studentul trebuie să cunoască concepțele de bază ale fizicii corpului solid și electronicii, principiile și tehniciile de achiziție a semnalelor și măsurilor electrice și fizice, dar și procesele tehnologice microelectronice. Utilizarea adecvată a fundamentelor teoretice ale științelor inginerești aplicate. |

4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru

| | |
|--------------------------|---|
| Curs | Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de auditoriu echipat cu: calculator, proiectoare, tabla interactivă. Curs, compendiu tipărit sau în formă electronică. Manuale, cărți în domeniu accesibile gratis în biblioteca UTM, în Internet. Materialele cursului sunt plasate pe platforma ELSE https://else.fcim.utm.md/course/view.php?id=230 În caz de situații excepționale, în baza ordinului administrației UTM, cursurile se petrec în format online pe platforma MS TEAMS. Studenții sunt înrolați pe platformele online în baza emailului corporativ al UTM. |
| Laborator/seminar | Pentru petrecerea lucrărilor de laborator în sală este nevoie de laborator dotat cu: calculatoare, tabla, cretă, echipamente de măsură analogice sau digitale, |

standuri de laborator, surse de tensiune și curent reglabile, cabluri de conexiune.

Indicații metodice tipărite sau în formă electronică. Îndrumarele de laborator sunt plasate pe platforma ELSE <https://else.fcim.utm.md/mod/folder/view.php?id=2428>

Vor fi efectuate atât lucrări de laborator experimentale cât și de simulare a caracteristicilor dispozitivelor semiconductoare în dependență de parametrii acestora. Simularea se va efectua în PSPICE sau Multisim.

Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor din indicațiile metodice și orarului. Termenul de predare a raportului pentru lucrarea de laborator – 2 săptămâni după efectuarea acestora. Pentru predarea/depunerea cu întârziere a raportului final corect al lucrării de laborator aceasta se depunțează cu 1 pct./săptămână de întârziere.

5. Competențe specifice acumulate

| | |
|-------------------------|---|
| Competențe profesionale | <p>C1.1 Descrierea funcționării dispozitivelor și circuitelor electronice și a metodelor fundamentale de măsurare a mărimilor electrice. C4 Proiectarea, simularea și testarea de dispozitive, circuite integrate și sisteme micro- și nanoelectronice cu instrumente software moderne. C6 Proiectarea, simularea și testarea de dispozitive, circuite și sisteme optoelectronice cu instrumente software și tehnologii moderne.</p> <p>C1.4. După parcurgerea disciplinei studenții vor fi capabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cunoștințe profunde despre procesele fizice, electronice, fotoelectronice și optoelectronice, caracteristicile și parametrii dispozitivelor semiconductoare, - modelele fizico-matematice, metodele și programe de calcul ale caracteristicilor și parametrilor și circuitelor echivalente ale dispozitivelor semiconductoare, - metodele de cercetare ale proprietăților și caracteristicilor dispozitivelor, - Cunoașterea structurii interne și funcționarea diferitor dispozitive micronanoelectronice; - Explicarea și interpretarea caracteristicilor și parametrilor dispozitivelor ele micronanoelectronice; - Identificarea și selectarea dispozitivelor micronanoelectronice conform simbolului tehnic și în funcție de destinația circuitului în care ele vor fi utilizate; - Alegerea dispozitivelor micronanoelectronice în funcție de caracteristici și parametri; - Dezvoltarea abilităților practice pentru verificarea, prin ridicarea caracteristicilor și determinarea parametrilor de bază a dispozitivelor electronice; - actualități, perspectiva și problemele dezvoltării în continuare ale ramurii. |
| Competențe transversale | <p>CT1. Implementarea de aplicații în practica inginerescă din domeniul specializării, folosind fundamente teoretice ale științelor inginerești aplicate.</p> <p>CT2. Demonstrarea capacității de lucru în echipă, identificarea rolurilor și responsabilităților individuale și comune, luarea deciziilor și atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.</p> <p>CT3. Realizarea laboratoarelor cu utilizarea corectă a surselor bibliografice și metodelor specifice, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată, precum și susținerea acestora cu demonstrarea capacității de evaluare calitativă și cantitativă a unor soluții tehnice din domeniu.</p> |

6. Obiectivele disciplinei/modulului

| | |
|-----------------------|--|
| Obiectivul general | Formarea cunoștințelor fundamentale în domeniul fizicii, proceselor electronice, modelelor fizico-matematice, care determină principiile de lucru, proprietățile, caracteristicile și parametrii precum și domeniile de aplicație ale diferitor dispozitive semiconductoare discrete și integrate - electronice, opoelectronice, microelectronice. |
| Obiectivele specifice | <ol style="list-style-type: none"> 1. Descrierea funcționării dispozitivelor și circuitelor electronice și a metodelor fundamentale de măsurare a mărimilor electrice. 2. Descrierea funcționării dispozitivelor și circuitelor electronice și a metodelor fundamentale de măsurare a mărimilor electrice. 3. Realizarea unui proiect de complexitate mică cu dispozitive și circuite electronice și caracterizarea acestuia cu instrumentația de măsură. |

7. Conținutul disciplinei/modulului

| Tematica activităților didactice | Numărul de ore | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| | învățământ cu frecvență | învățământ cu frecvență redusă |
| Tematica cursurilor | | |
| T1. INTRODUCERE. Clasificarea materialelor semiconductoare după criterii chimic, fizic și funcțional. Proliferarea microelectroniciei. Legea lui Moore. | 2 | |
| T2. INTRODUCERE ÎN FIZICA DISPOZITIVELOR SEMICONDUCTOARE. Teoria benzilor pentru solide. Semiconductori intrinseci, extrinseci. Parametri, caracteristici, curenți. | 2 | |
| T3. JONCȚIUNEA P-N. Noțiuni generale. Formarea joncțiunii p-n. Modelul fizic și calculul parametrilor de bază. | 6 | |
| T4. INTERFAȚA METAL-SEMICONDUCTOR: Contactul Me-SC, Bariera Schottky, contactul Ohmic. | 4 | |
| T5. DIODE SEMICONDUCTOARE. Clasificarea. Dioda redresoare, Zener, stabistorul, diode de frecvențe înaltă, parametri, caracteristici, procese fizice, modele liniarizate de funcționare | 4 | |
| T6 . DIODA GUNN, TUNEL, PIN, principii de funcționare, parametrii. | 2 | |
| T7. TIRISTOARE, funcționarea, parametrii. | 3 | |
| T8. TRANZISTORUL BIPOLAR, Structura și funcționarea tranzistoarelor bipolare. | 6 | |
| T9. MODEL ANALITIC ȘI CALCULUL CARACTERISTICILOR TRANZISTORULUI BIPOLAR | 4 | |
| T10. TRANZISTOARELE CU EFECT DE CÂMP. Clasificarea, principiul de funcționare a TEC-J, parametri și caracteristici | 4 | |
| T11. TRANZISTOARELE TEC-MOS. Clasificarea, principiul de funcționare a TEC-MOS, parametri și caracteristici | 4 | |
| T12. HETEROJONCȚIUNI. clasificarea, principiul de funcționare | 4 | |
| Total curs: | 45 | |
| Tematica lucrărilor practice/seminarelor | | |
| S1. Fizica materialelor semiconductoare. | 2 | |
| S2. Calculul joncțiunii p-n | 2 | |
| S3. Calculul joncțiunii p-n. | 2 | |
| S4. Calculul parametrilor diodelor semiconductoare. | 2 | |
| S5. Calculul parametrilor și caracteristicilor tranzistoarelor bipolare. | 3 | |
| S6. Calculul parametrilor și caracteristicilor tranzistoarelor TEC-J. | 2 | |
| S7. Calculul parametrilor și caracteristicilor tranzistoarelor TEC-MOS. | 2 | |
| Total lucrări practice/seminare: | 15 | |

Tematica lucrărilor de laborator

| | | |
|---|---|-----------|
| LL1. Introducere în tehnica securității muncii și securitatea electrică la efectuarea lucrărilor de laborator. Cercetarea caracteristicilor tranzistorului cu efect de câmp. | 4 | |
| LL2. Cercetarea caracteristicilor capacitive a structurilor cu barieră semiconductor-semiconductor și metal-dielectric-semiconductor. | 4 | |
| LL3. Modelarea și calculul diodei Semiconductoare și a diodei Zenner. | 4 | |
| LL4. Cercetarea parametrilor și caracteristicilor Diodei cu efect Tunel. | 4 | |
| LL5. Cercetarea caracteristicilor tiristorului | 4 | |
| LL6. Modelarea și calculul tranzistorului Bipolar. | 4 | |
| LL7. Modelarea și calculul tranzistorului TEC-J. | 4 | |
| LL8. Modelarea și calculul tranzistorului TEC-MOS. | 2 | |
| Total lucrări de laborator/seminare: | | 30 |

8. Referințe bibliografice

| | |
|--------------|---|
| Principale | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertu Gașin, Petru Gaugaș. Fizica dispozitivelor semiconducțoare, Chișinău 1998; 2. Bîrsan Radu. Fizica și tehnologia circuitelor MOS integrate pe scară largă, București 1989; 3. S. Șișianu, T. Șișianu, O. Lupan, Comunicații prin fibre optice, Chișinău 2004 4. Лебедев А. И. Физика полупроводниковых приборов. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 488 с. 5. Marin Sărăcin, Cristina Gabriela Sărăcin, Măsurări electronice și sisteme de măsurare, București, 2003, 199 p. 6. http://www.comm.pub.ro/_curs/metc/curs_ro.htm S. Ciocchina, Măsurări Electrice și electronice, partea II, Litografia UPB, 1999 7. Alimpie Ignea. Măsurări electrice și electronice. Universitatea „Politehnica” din Timișoara / http://www.meo/etc.upt.ro/materii/cursuri/MEE/Curs.pdf 8. Anca Gheorghiu, Ion Spănulescu, Măsurări electrice, București, 2002, 526 p. 9. Mihai Miron, Liliana Miron. Masurari electrice și electronice. Ed. Academiei Fortelor Aeriene „Henri Coanda”, Brașov, 2003 10. http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/29065/1/978-5-7996-1330-3_2014.pdf. 11. А.С. Волегов и др. Электронные средства измерений физических величин. Екатеринбург, Издательство Уральского университета 2014, с. 104. 12. Г.Я. Мирский. Электронные измерения (1986), М., Радио и связь. Справочник по радиоизмерительным приборам. Под ред. В.Насонова, т. 1, 2. М., Советское радио, 1976 |
| Suplimentare | <ol style="list-style-type: none"> 1. Электронные измерения, Методические указания к лабораторным работам, Кишинэу, ТУМ, 2003, составитель Н.Н. Арменча, 128 с. 2. Stepanenco I. „Osnovî microelectroniki” – М., SOV, radio, 1980, 40 ex. 3. Avaev N., Naumov Iu. „Osnovî microelectroniki”, 1991, 40 ex. 4. Îndrumar pentru lucrări de laborator (versiune electronica), versiune tipar distribuită studenților. |

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
|  UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI | FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI | Cod: FD/M 8.1 Ediţia 1 Revizia 0 Pagina |
|--|-----------------------------------|--|

9. Evaluare

| Periodică | | Currentă | Studiu individual | Proiect/teză | Examen |
|-----------|------|----------|-------------------|--------------|--------|
| EP 1 | EP 2 | | | | |
| 15% | 15% | 15% | 15% | - | 40% |

Standard minim de performanță

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator;

Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator;

Obținerea notei minime de „5” la examen;

Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii procedurilor și metodelor de măsurare a parametrilor și caracteristicilor dispozitivelor electronice, principiul de funcționare, calculul parametrilor.

| Data completării | Titular curs | Responsabil(i) aplicații |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 01.09.2021 | Dr., conf. Eduard MONAICO | Dr., conf. Eduard MONAICO |